

C. RECOMMANDATIONS DE NOTATIONS :**Complexes**

$|X|$ norme de X \underline{X} grandeur complexe \underline{X}^* grandeur complexe conjuguée

Lettres

I, i Courants (A)
 U, u Tensions (V) (V, v sont tolérés)
 P, p Puissances (W)
 W, w Work, energie ou travail (J)
 t Temps (s)
 τ Constante de temps (s)
 T Température (K)
 f fréquences (Hz)
 ω pulsations (rd/s)
 C Capacités (F)
 L Inductances (H)
 φ, θ Déphasages (rd)
 A Amplification, ou atténuation (dB)

$\underline{Z}, \underline{z}$ Impédances
 (Z non souligné est toléré pour alléger l'écriture)

R, r Re(\underline{Z}), ou résistances (Ω)

X, x Im (\underline{Z}) ou réactances (Ω)

$\underline{Y}, \underline{y}$ Admittance (= 1/ \underline{Z})

B, b Im(\underline{Y}), ou susceptances (Ω^{-1})

H, h Paramètres hybrides (matrices)

G, g Re(\underline{Y}), conductances (Ω^{-1}), ou matrice hybride.

Indices

O, o, 22, 2 Out, sortie
 I, i, 11, 1 In, entrée
 12 Transfert inverse
 21 Transfert direct
 AV, av Average, moyenne
 F, f Forward, direct
 M, m Maxima
 MIN, min Minima
 tot Total
 R, r Reverse, Inverse
 SC, sc Shortage, court-circuit
 S, SS, SAT Saturation
 BR Break, claquage
 OV Overload, surcharge
 N, n Noise, bruit
 p Pic, crête
 pp Pic à pic, crête à crête
 Q, q Quiet, repos
 T Diélectrique, déplétion

Transistor Bipolaire

E, e Emitter, émetteur d'un transistor bipolaire
 (Peut être utilisé pour l'entrée, si cela n'induit pas d'ambiguïté)
 B, b Base d'un transistor bipolaire
 C, c Collector, collecteur d'un transistor bipolaire

Transistor à effet de champ

S, s Source d'un transistor à effet de champ
 Peut être utilisé en sortie, si cela n'induit pas d'ambiguïté
 G, g Gate, Grille d'un transistor à effet de champ
 D, d Drain d'un transistor à effet de champ